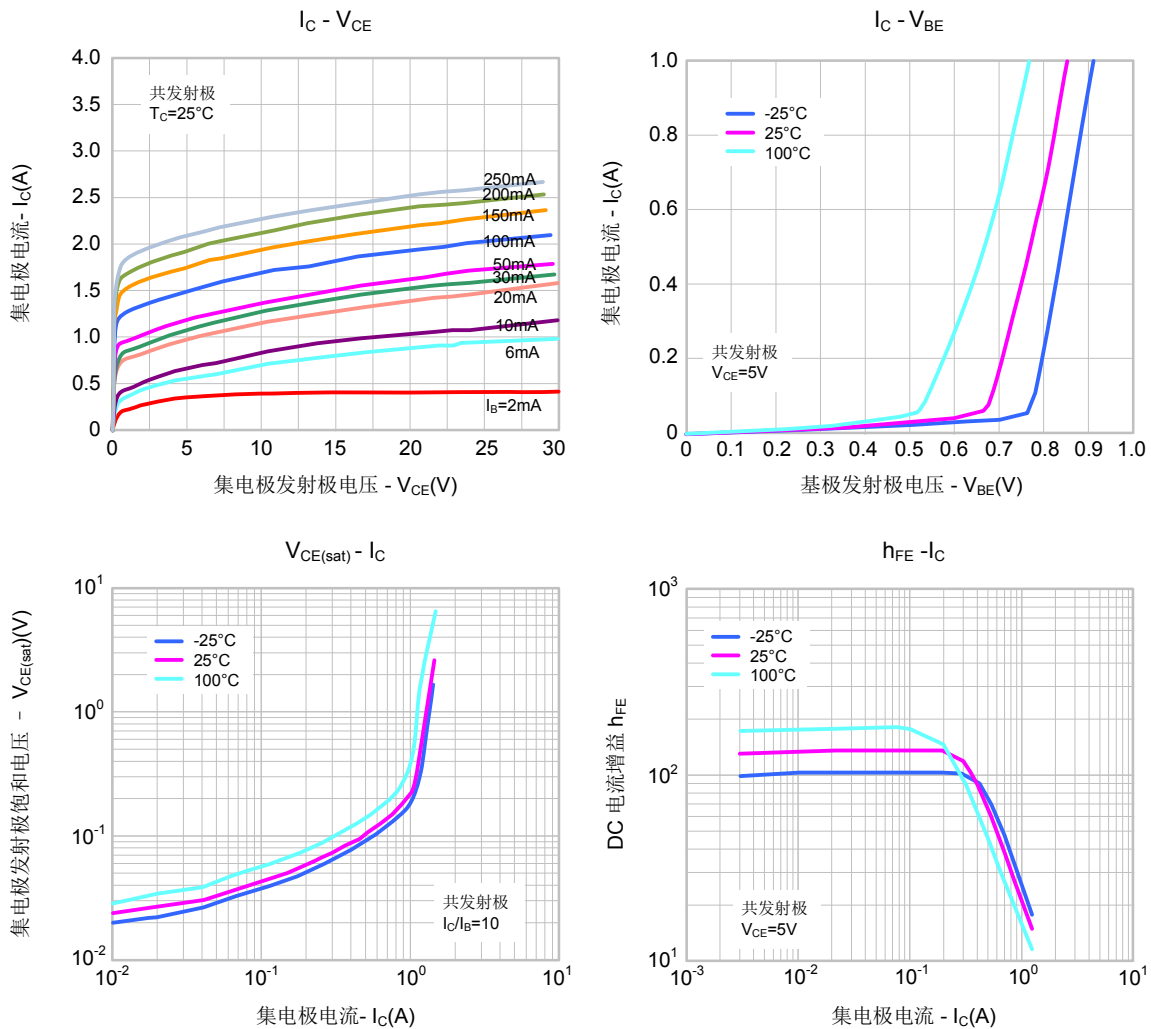


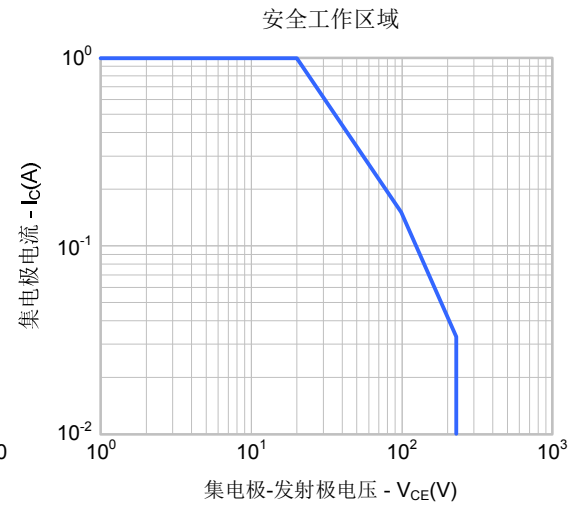
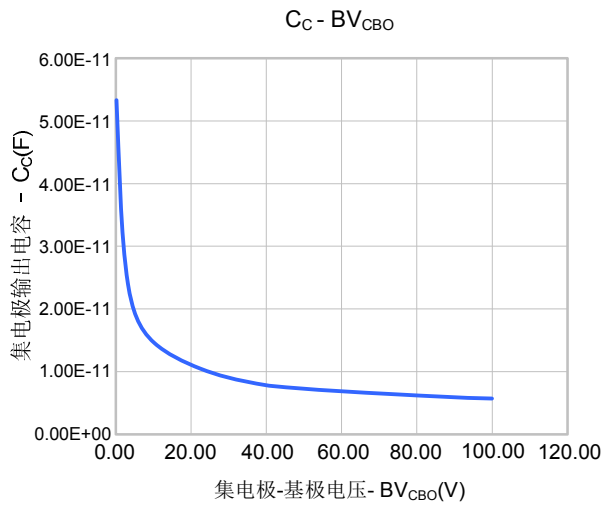
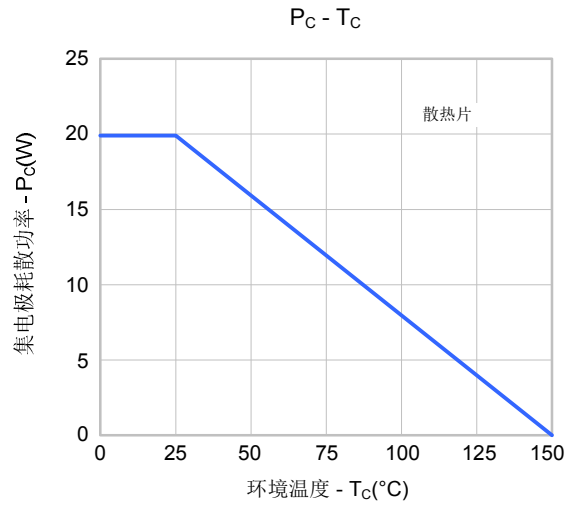
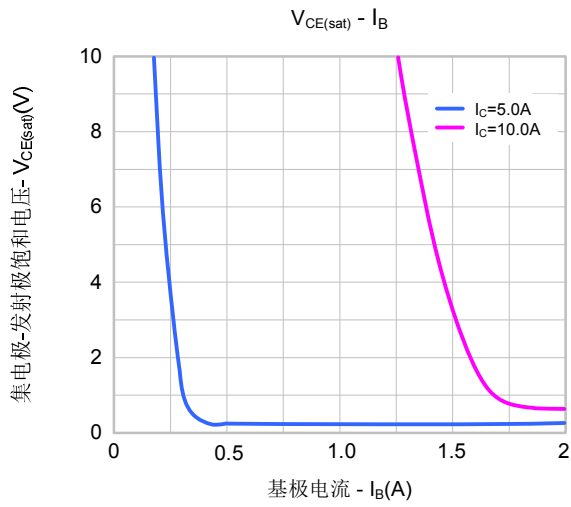
电参数(除非特殊说明, $T_a=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=100\text{mA}$	100	--	320	--
集电极、发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	--	--	1	V
基极、发射极电压	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=500\text{mA}$	--	--	1	V
集电极、基极漏电电流	I_{CBO}	$V_{CB}=250\text{V}, I_E=0$	--	--	1	μA
集电极、发射极漏电电流	I_{CEO}	$V_{CE}=230\text{V}, I_B=0$	--	--	20	μA
发射极、基极漏电电流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	--	--	1	μA
三极管频率	FT	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-100\text{mA}$	--	70	--	MHZ
集电极输出电容	C_{OB}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	--	15	--	pF

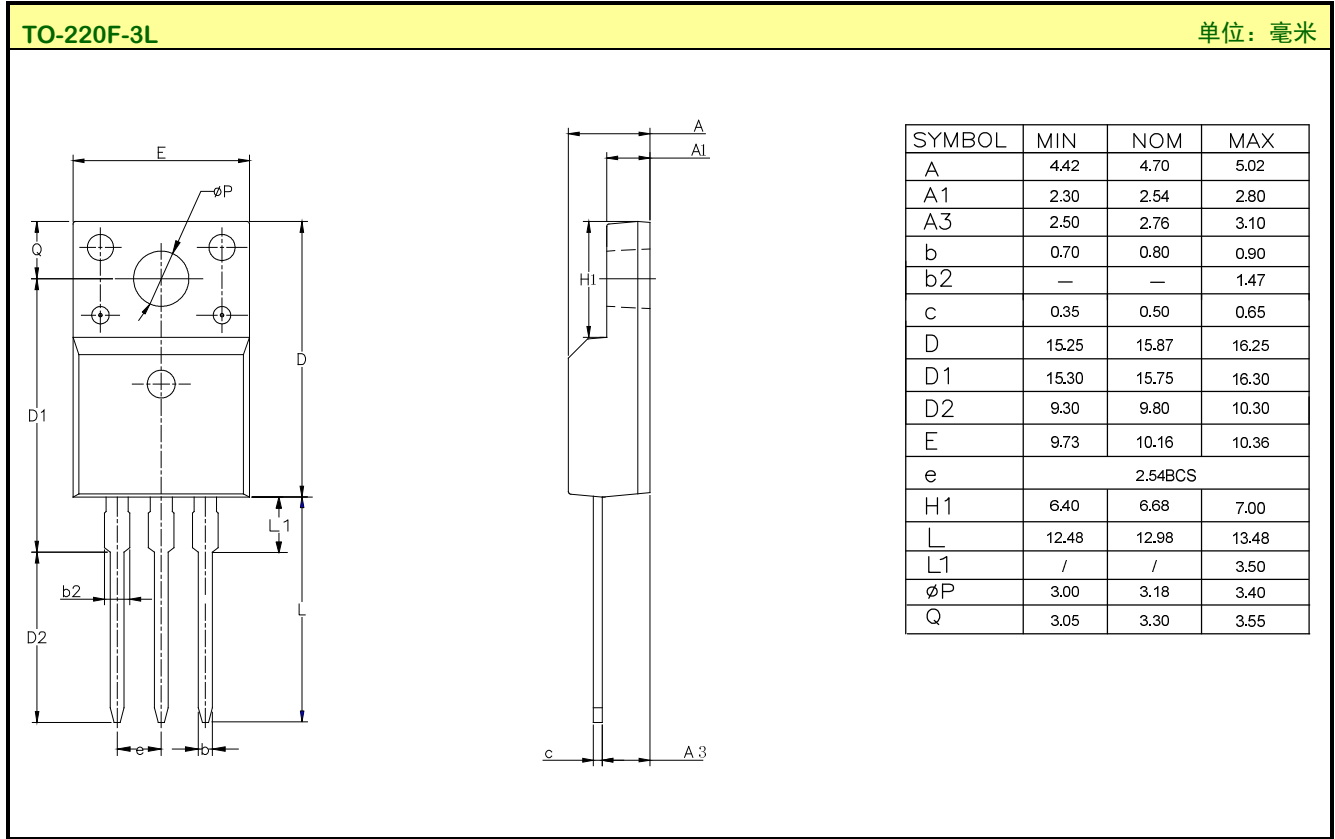
典型特性曲线



典型特性曲线



封装外形图



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- ◆ 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

产品名称:	SJT4793NF	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本:	1.1	作 者:	殷资
------	-----	------	----

修改记录:

1. 修改封装信息
-

版 本:	1.0	作 者:	林莹
------	-----	------	----

修改记录:

1. 正式发布版本
-
-